



MEMORIA RAM KINGSTON DDR4 2666MHZ 8GB NON-ECC CL19 SO-DIMM

La memoria RAM Kingston DDR4 2666MHz 8GB Non-ECC SO-DIMM KVR26S19S8/8 es un componente de alta calidad diseñado para mejorar el rendimiento y la velocidad del sistema. Con una temperatura operativa que oscila entre los 0 y los 85 u00b0C, esta memoria ofrece un tiempo activo en fila de 32 ns y es compatible con sistemas operativos Windows. Con un ancho de tan solo 69.6 mm, este modulo cuenta con tecnologia DDR4 y opera a un voltaje de memoria de 1.2 V. Su diseno consta de un unico modulo de tamano estandar (1 x 8 GB) con una latencia CAS igual a 19. Ademias, cumple con las certificaciones RoHS por su compromiso medioambiental al no contener halogenos en su composicion. El intervalo recomendado para almacenamiento se encuentra entre -55u00b0C hasta los +100u00b0C sin afectar su funcionamiento optimo. Este modelo no incluye ECC pero tiene capacidad suficiente para manejar aplicaciones exigentes gracias a sus clasificacion como tipo uno; tambien posee una velocidad reloj maxima alcanzable por cada ciclo equivalente a los impresionantes valores nominales establecidos: u00a1hasta unos sorprendentes e increibles!u00a02666 MHz Su altura total es solamenteu00a030mm lo cual permite ser instalada facilmente en cualquier equipo portatil o notebook ya sea nuevo o antiguo debido al factor forma standardizado denominado "260-pin SO-DIMM". Ademias, presenta tiempos actualizacion ciclo fila muy bajos (350ns), asi como programacion power voltage (VPP) bajo control seguro (2.5V). En resumen, si buscas una memoria RAM de alta calidad y rendimiento para tu portatil, la Kingston DDR4 2666MHz 8GB Non-ECC SO-DIMM KVR26S19S8/8 es una excelente opcion. Con su diseno compacto, tecnologia avanzada y certificaciones medioambientales, esta memoria ofrece un gran valor a cualquier usuario que desee mejorar el rendimiento de su equipo sin comprometer la seguridad del mismo.

Peso y dimensiones

Altura

30 mm

Ancho

69.6 mm

Detalles tecnicos

Doesn't contain

Halogeno

Sustainability certificates

RoHS

Memoria

Latencia CAS

CL19

Diseno de memoria (modulos x tamano)

1 x 8GB

Componente para

Portatil

Voltaje de memoria

1.2 V

Configuracion de modulos

1024M x 64

Tiempo activo en fila

32 ns

Tipo de memoria interna

DDR4

Memoria RAM

8GB

Clasificacion de memoria

1
Velocidad de memoria del reloj
2666MHz
ECC
No
Programming power voltage (VPP)
2.5 V
Tiempo de ciclo de fila
45.75 ns
Tiempo de actualizacion de ciclo de fila
350 ns
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Si
Otras características
Factor de forma
260-pin SO-DIMM
Diseño
JEDEC standard
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-55 - 100 °C
\$301.09MN